



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

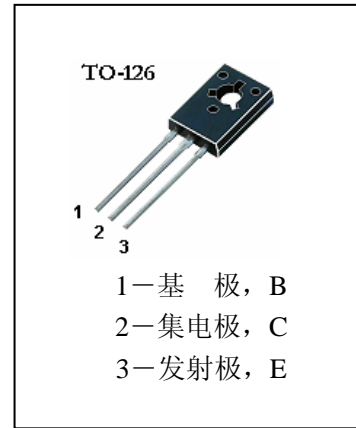
**H13003H**

对应国外型号

■ 主要用途

高压快速开关

■ 外形图及引脚排列



■ 极限值 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度	-65~150 $^\circ\text{C}$
$T_j$ ——结温	150 $^\circ\text{C}$
$P_C$ ——集电极功率耗散 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	40W
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压	700V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压	450V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压	9V
$I_C$ ——集电极电流 (DC)	2A
$I_B$ ——基极电流	0.75A

■ 电参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	450			V	$I_C=5\text{mA}$ , $I_B=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			10	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=9\text{V}$ , $I_C=0$
$HFE(1)$	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=5\text{V}$ , $I_C=0.5\text{A}$
$HFE(2)$		5				$V_{CE}=2\text{V}$ , $I_C=1\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			0.5	V	$I_C=0.5\text{A}$ , $I_B=0.1\text{A}$
				1	V	$I_C=1\text{A}$ , $I_B=0.25\text{A}$
				2	V	$I_C=1.5\text{A}$ , $I_B=0.5\text{A}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和压降			1	V	$I_C=0.5\text{A}$ , $I_B=0.1\text{A}$
				1.2	V	$I_C=1\text{A}$ , $I_B=0.25\text{A}$
$f_T$	特征频率	4			MHz	$V_{CE}=10\text{V}$ , $I_C=0.1\text{A}$
$t_{ON}$	导通时间			1.1	$\mu\text{S}$	} $V_{CC}=125\text{V}$ , $I_C=1\text{A}$ $I_{B1}=0.2\text{A}$ , $I_{B2}=-0.2\text{A}$ $R_L=125\Omega$
$t_{STG}$	贮存时间			4.0	$\mu\text{S}$	
$t_F$	下降时间			0.7	$\mu\text{S}$	

■ 分档及其标志

H1	H2	H3	H4	H5
10-16	14-21	19-26	24-31	29-40



■ 特性曲线

Fig 1. DC Current Gain

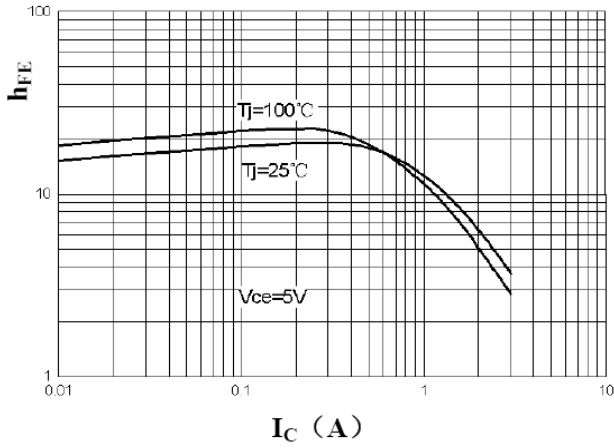


Fig 2. Collector-Emitter Saturation Voltage

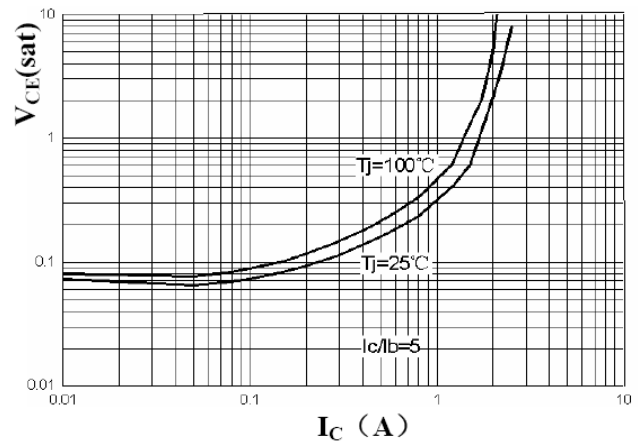


Fig 3. Base-Emitter Saturation Voltage

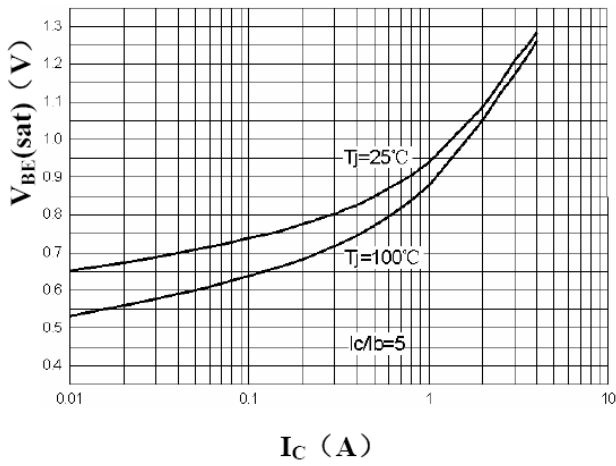


Fig 4. Safe Operation Areas

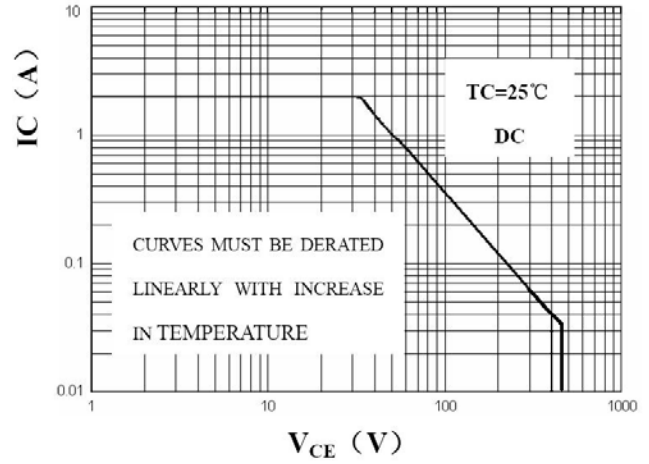
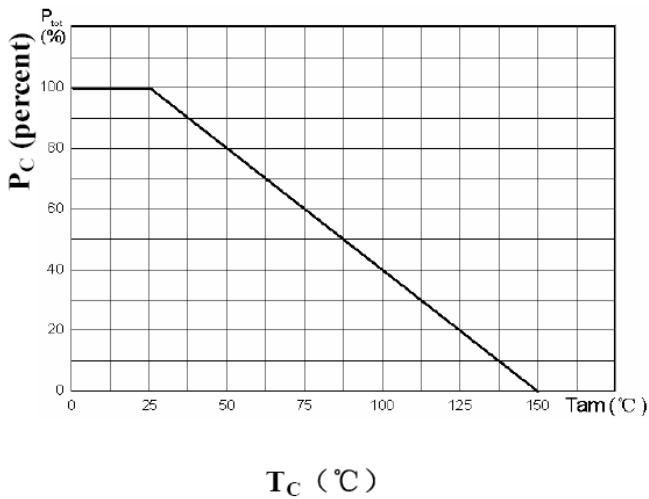


Fig 5. Power Derating Curve





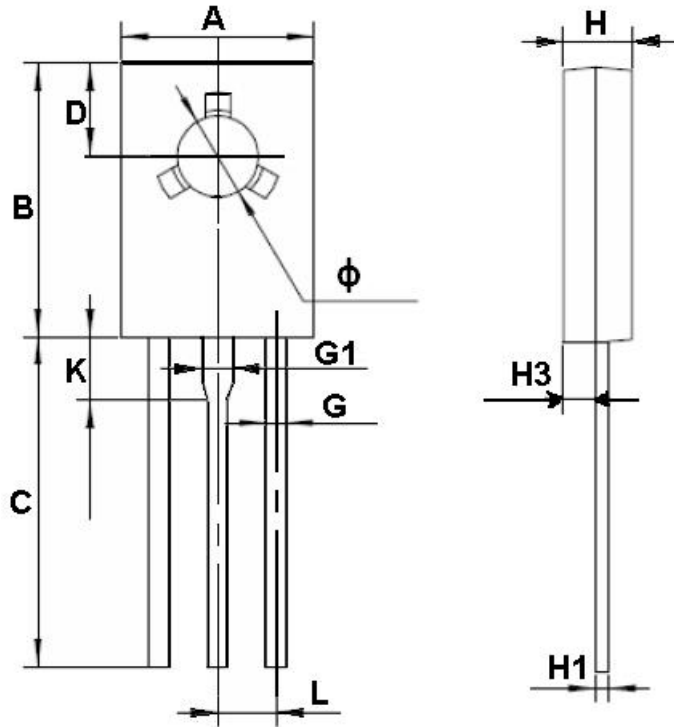
汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**H13003H**

对应国外型号

■ 外形尺寸图



尺寸 符号	Min	Max	尺寸 符号	Min	Max	尺寸 符号	Min	Max
<b>A</b>		8.5	<b>G1</b>	(1.2)		<b>K</b>	2.3	2.7
<b>B</b>		12.0	<b>H</b>		2.8	<b>L</b>		2.3
<b>C</b>	13.0		<b>H1</b>	0.49	0.57	$\phi$	3.0	3.4
<b>D</b>	3.6	4.0	<b>H3</b>	(1.27)				
<b>G</b>	0.7	0.86						

注：（）内数值为参考值